



ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ



Ф.И.О. Абдикаримов Азамат Эгамбергенович
 ДОЛЖНОСТЬ Старший преподаватель
 ТЕЛ: + 99899 5909376
 E – mail: abukarimov.azamat@rambler.ru ;
azamat.abdikarimov@urdu.uz
 ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕФОН: +99862 2246700
 ОРГАНИЗАЦИИ АДРЕС: г.Ургенч, ул.Х.Олимджана 14, 220100

ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНЬ	2000 – 2004 гг. – студент Ургенчского государственного университета 2004 – 2006 гг. – магистрант Ургенчского государственного университета 2021- доктора философии (PhD) по физико-математическим наукам по специальности физика полупроводников (01.04.10)
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:	2000 – 2004 гг. – студент Ургенчского государственного университета 2004 – 2006 гг. – магистрант Ургенчского государственного университета 2006 – 2007 гг. – преподаватель 2-Академического лицея при Ургенчском государственном университете 2007 – 2009 гг. – ассистент-преподаватель кафедры “Физика” Ургенчского государственного университета 2009 – 2015 гг. – преподаватель кафедры “Физика” Ургенчского государственного университета 2015 – 2016 гг. – старший преподаватель кафедры “Физика” Ургенчского государственного университета 2015 – 2019 гг. – опорный докторант кафедры “Физика” Ургенчского государственного университета 2019 г. – до н.в. . – старший преподаватель кафедры “Физика” Ургенчского государственного университета
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ	Физика.
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ	Термодинамика и статическая физика, Моделирование полупроводниковых приборов, физические основы фотовольтаики
ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:	Моделирование полупроводниковых приборов, полупроводниковые многослойные структуры, МОП структуры, МОП транзисторы, FinFET транзисторы, беспереходные МОП транзисторы, короткоканальные эффекты в наноразмерных МОП транзисторах, случайные телеграфные шумы, радиационная физика полупроводниковых приборов.
ПРОЕКТЫ:	2016-2019. RENES – “ Development of the Master program in renewable energy and sustainable environment” (Erasmus+ program). 2017-2020. “ New approach to investigation of the nature and lateral distribution of the

	defects at Si-SiO₂ interface and in the oxide layer”. Ministry of innovational development of Uzbekistan. 2021-2023. Совместный Индийско-Узбекский проект “Self Heating Effect on stacked Nanosheet Field Effect Transistor”
ПУБЛИКАЦИИ	1. Atamuratov A. E., Abdikarimov A., Khalilloev M., Atamuratova Z. A., Rahmanov R., Garcia-Loureiro A., Yusupov A. Simulation of DIBL effect in 25 nm SOI-FinFET with the different body shapes // -2017. Nanosystems: Physics. Chemistry. Mathematics. 8 (1). pp. 71–74. (01.00.00, №5) 2. Abdikarimov A., Atamuratov A.E., Khalilloev M., Atamuratova Z. A., Rahmanov R., Yusupov A. Simulation Study Of Subthreshold Slope in 25 nm SOI-FinFET With The Different Body Shape // 2017. ДАН. № 3. с. 20-23. (01.00.00, №7) 3. Abdikarimov A.E., Yusupov A., Atamuratov A.E. The effect of the fin shape and thickness of the buried oxide on the DIBL effect in an SOI FinFET // -2018. Technical Physics Letters. Vol.44. No.11. pp. 962-964. (Scopus IF= 0.791) 4. Абдикаримов А.Э., Юсупов А., Атамуратов А.Э., Влияние бокового расширения затвора на короткоканальные эффекты в нанометровом кнн FinFET-транзисторе // - 2019. УФЖ. Vol. 21. №1. pp. 50-52. (01.00.00, №5) 5. Abdikarimov A.E., Yusupov A., Atamuratov A.E. Intercapacitance between two charges located in the different environments // - 2018. Actual problems of modern science, education and training in the region. IV. pp. 33-37. (01.00.00, №10) 6. Abdikarimov A., Atamuratova Z. A., Yusupov A. Simulation study of short channel effects in low power FinFETs with different body shape and geometries // - 2018. International journal of applied science-research and review. Volume 5, pp. 41. (01.00.00, №5) 7. Abdikarimov A.E. The Influence of a Single Charged Interface Trap on the Subthreshold Drain Current in FinFETs with Different Fin Shapes // - 2020. Technical Physics Letters.– Vol. 46. No.5. pp. 494-496. (Scopus IF= 0.791) 8. Abdikarimov A., Indalecio G., Comesana E., Seoane N., Kalna K., Garsia-Lourero A. J., Atamuratov A. E. Influence of device geometry on electrical characteristics of a 10.7 nm SOI-FinFET //– 2014. IEEE Xplore Digital Library. pp. 1-4. [Online] Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/-6865877 International Workshop on Computa-tional Electronics (IWCE). Paris. pp. 1-4, doi: 10.1109/IWCE.2014.6865877 9. Abdikarimov A. E., Matyusupova N.B. Simulation of the effect of a single interface trapped charge in finfet with a gate length of 10 nm on the short channel effects // -2020. Electronic journal. VI. Actual problems of modern science, education and training. December-15. - pp.316-322. Issue1, ISSN Online: 2181-9750 [Online] Available: http://khorezmscience.uz/en/index/single/1 10. Abdikarimov A., Indalecio G., Comesana E., Seoane N., Kalna K., Garsia-Lourero A.J., Atamuratov A.E. Influence of device geometry on electrical characteristics of a 10.7 nm SOI FinFET // -2014. 17th International Workshop on Computational Electronics (IWCE 2014). Conference. Paris. France. June 3-6, pp. 247-248 11. Абдикаримов А., Ражабов О., Юсупов А. , Атамуратов А.Э. Влияние формы базы и толщины скрытого оксидного слоя на DIBL эффект в кнн FinFET-транзисторе // - 2018. Республика илмий-техникавий анжуман, Мухаммад Ал-Хоразмий издошлари. Урганч. 27-28 апрель 9 -10 б. 12. Абдикаримов А.Э., Ражабов О., Юсупов А., Атамуратов А.Э. Влияние бокового линейного расширения затвора на пороговое напряжение и короткоканальные эффекты в кнн FinFET-транзисторе с различной формой канала // -2018. IV Международной конференции по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро-и нано структурах. Фергана. 25-26 мая. с. 318-319. 13. Абдикаримов А.Э., Юсупов А., Атамуратов А.Э. Влияние формы базы и толщины скрытого оксидного слоя на крутизну передаточной характеристики кнн FinFET-транзистора // - 2018. Материалы Республиканской конференции. Роль одаренной молодежи в развитии физики. Тошкент. 11-12 мая. с. 23-25.

14. Абдикаримов А.Э., Садуллаев С., Атамуратов А.Э. Влияние удлинения подзатворного оксидного слоя на крутизну передаточной характеристики и DIBL эффект в FinFET-транзисторе // - 2018. International conference. Prospects for the intensive approach to innovative development. - Namangan. 10 - 11 July. pp. 222-223.
15. Абдикаримов А.Э., Юсупов А., Атамуратов А.Э. Влияние толщины скрытого оксидного слоя на DIBL эффект в FinFET-транзисторе // - 2018. Республика илмий-амалий анжуман. Яримўтказгичлар физикасининг ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришнинг замонавий муаммолари. Андижон, 20 - 21 апрель. 90 – 91 б.
16. Абдикаримов А.Э., Юсупов А., М. Халиллоев., Атамуратов А.Э. Влияние удлинения подзатворного оксидного слоя на передаточную подпороговую характеристику и DIBL эффект в FinFET-транзисторе с различной формой базы // - 2018. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Яримўтказгичлар физикасининг ҳозирги замон муаммолари. -Тошкент. 26-27 октябрь. 84-86 б.
17. Абдикаримов А.Э., Юсупов А., Ражабов О., Ахмедова С., Атамуратов А.Э. Влияние удлинения подзатворного оксидного слоя на короткоканальные эффекты в FinFET-транзисторе // -2018. Материалы республиканской научно-практической конференции. Инновационные технологии в науке и образовании. Нукус. 20-21 ноября. С. 121-124.
18. Абдикаримов А.Э., Садуллаев С., Нуруллаев Н., Атамуратов А.Э., Юсупов А. Распределение амплитуды сигнала случайного телеграфного шума вдоль канала FinFET транзистора с различной формой // – 2019. Республиканской конференции (с участием ученых стран СНГ). Современные проблемы физики полупроводников. Нукус. 20 ноября. С. 276-279.
19. Yusupov A., Atamuratov A., Abdikarimov A. The amplitude of RTN in nanometer SOI FinFET with different channel shape // - 2020. World Scientific Proceedings Series on Computer Engineering and Information Science 12. Developments of Artificial Intelligence Technologies in Computation and Robotics. Proceedings of the 14th International FLINS Conference . pp.1541-1548.
20. Абдикаримов А.Э., Атамуратов А.Э., Юсупов А. Канал узунлиги 10 нм бўлган вертикал майдоний транзисторнинг оксид-яримўтказгич қатлам чегара сиртидаги нуқсонда камралган яқка заряднинг DIBL эффектига таъсирини моделлаштириш // - 2020. Замонавий микроэлектрониканинг ривожланишида фан, таълим ва инновация интеграцияси. Андижон. 24 - 25 декабрь. 183–185 б.
21. Для получения свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ Агентством интеллектуальной собственности Республики Узбекистан создана программа EXM «Расчет эффекта снижения потенциального барьера запасом в вертикальных полевых транзисторах в наномасштабе». № DGU 20180753. Составлен бюллетень Агентства интеллектуальной собственности.
22. В целях получения свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ, созданной Агентством интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, компьютерная программа «Расчет наклона низкороговой вольт-амперной характеристики в вертикальном поле- Эффект транзисторов в наномасштабе »был создан № DGU 20180754. опубликован в бюллетене.